



「いまさら聞けないパワー半導体基礎」

◇ 日時：2023年10月26日(木) 10:00~18:00 (後日、講演動画のWeb配信有り)

◇ 場所：名古屋大学 東山キャンパス ES総合館 1F ESホール

名古屋市千種区不老町 地下鉄名城線「名古屋大学」駅下車 徒歩1分

パワー半導体デバイスは、電力機器の効率、大きさ、重量を決定づける極めて重要な部品であり、その性能向上に向けた研究開発が精力的に進められています。デバイス開発の過程においては、設計通りの特性が得られない、場合によっては素子が動作しないなど不具合が多発します。そのような場面に遭遇した際、評価結果を真に理解するには、半導体物性、動作原理の本質的な理解が不可欠になるのですが、半導体について一度勉強されていても、その全てを正確に理解できているか不安・・・という方は多いのではないのでしょうか。

今回は、パワー半導体業界の最前線で活躍されている講師の先生方に、パワー半導体の基礎をわかりやすく解説していただきます。「恥ずかしくていまさら聞けない・・・」という悩みを解消しませんか？

特に、学生さん、若手エンジニアの方々のご参加をお待ちしております。

..... プログラム

9:30 開場

10:00~10:10 開会の挨拶、本日の進行説明

10:10~12:00 半導体基礎・pn接合の理論

須田 淳 (名古屋大学)

12:00~13:00 休憩

13:00~14:30 MOS構造の原理と特性評価

細井 卓治 (関西学院大学)

14:30~14:40 休憩

14:40~16:10 金属/半導体界面

小出 康夫 (物質・材料研究機構)

16:10~16:20 休憩

16:20~17:50 高電界現象の基礎

前田 拓也 (東京大学)

17:50~18:00 閉会の挨拶

.....

■ 参加受付: WEB参加受付システム ([ここ](#)をクリック*)から参加登録と参加費の決済をお願いします。

■ 後配信について: 参加登録いただいた方全員に、後日期間限定で講演動画(講義部分のみ、質疑無し)をWeb配信致します。現地参加されるかは登録時に選択をお願いします。(席数に限りがあるため、現地参加については早期に締め切る可能性がございます)

■ 参加費: (消費税込み)

先進パワー半導体分科会学生会員 無料、一般学生 1,000円、

先進パワー半導体分科会会員* 4,000円、一般 6,000円

*先進パワー半導体分科会賛助会員所属の方は先進パワー半導体分科会会員扱いとします。

■ 現地開催におけるご協力のお願い: 発熱がある場合は当日の現地参加はご遠慮ください。会場でのマスクの着用は任意とします。

■ 問い合わせ先:

新井 学 (名古屋大学)

e-mail: marai@imass.nagoya-u.ac.jp

田中 亮 (富士電機)

e-mail: tanaka-ryou@fujielectric.com